

**ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ
В МОНОКРИСТАЛЛАХ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$**

A. V. Баженов, B. B. Тимофеев

Важным этапом на пути к пониманию механизма высокотемпературной сверхпроводимости является выяснение электронной структуры как сверхпроводящей фазы, так и соответствующих ей металлического и диэлектрического состояний. В предлагаемой работе изучаются низкоэнергетичные электронные переходы в первую очередь в области 0.5 эВ, которые могут служить медиаторами спаривания свободных носителей в сверхпроводнике. Наличие перехода 0.5 эВ в $\text{La}(\text{Sr})\text{CuO}$ и $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+r}$ (123) не вызывает сомнений, однако имеющаяся информация о его свойствах противоречива, что объясняется сложным строением исследовавшихся объектов: керамик, порошков, эпитаксиальных пленок [1], ориентированных керамик [2]. Недавно в спектрах отражения света монокристаллами La_2NiO_4 , La_2CuO_4 [3, 4], $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ [5] обнаружено, что переход 0.5 эВ анизотропен, активен в поляризации $E \perp C$ (C — нормаль к купратной плоскости). В ряде работ утверждается, что сила осциллятора этого перехода уменьшается с увеличением концентрации свободных носителей в соединениях 123 [1], La_2CuO_4 [5]; в других работах переход наблюдается и в высокопроводящих эпитаксиальных пленках LaSrCuO [6], в соединениях 123 в виде монокристаллов [7], ориентированных пленок [8], порошков [9], причем в 123 симметрия перехода неизвестна.

Исследовались монокристаллы 123 размером $2 \times 3 \times 0.5$ мм, полученные раствор-расплавным методом с использованием алундового тигля. Исходные кристаллы переходили в сверхпроводящее состояние при $T_c = 60$ К. Для выяснения влияния содержания кислорода на свойства перехода 0.5 эВ проводились последовательные изохронные отжиги образцов в вакууме 10^{-5} бар в течение 17 ч при 100, 200 и 300 °C. Спектры отражения света измерялись на Фурье-спектрометре при 300 К в спектральном диапазоне от 50 до 6000 cm^{-1} в геометрии, близкой к нормальному падению линейно-поляризованного света с волновым вектором $q \perp C$. С помощью поляризационного оптического микроскопа было установлено, что исходные кристаллы неоднородны. Методом ИК микроскопии и комбинационного рассеяния света были измерены локальные спектры отражения и спектральные положения линии полносимметричного валентного колебания мостикового кислорода в различных областях образца. Оказалось, что монокристалл, среднее содержание кислорода в котором $x = 0.4$, является системой, макроскопически расслоенной на области с $x = 0.6$ и 0.25 с высокой и низкой высокочастотной проводимостью соответственно.

В спектре отражения исходного монокристалла (рис. 1) наблюдается широкая линия с максимумом около 3500 cm^{-1} . В спектре поглощения, полученном преобразованием спектра отражения с помощью соотношений Крамерса—Кронига, этой линии соответствует особенность 0.6 эВ. Существенным результатом является то, что, во-первых, данный переход наблюдается только в поляризации $E \perp C$, во-вторых, с уменьшением содержания кислорода наряду с уменьшением отражения, обусловленного свободными носителями, исчезает и линия 3500 cm^{-1} .

Ярко выраженная анизотропия перехода 0.6 эВ свидетельствует о том, что он происходит в высокосимметричной точке зоны Бриллюэна (рис. 2). В соответствии с теоретическими расчетами [10, 11] такой переход по аналогии с внутрицентровым $d-d$ переходом в Cu^{2+} [8] можно объяснить возбуждением электрона из ветви, расположенной ниже уровня Ферми, в пул-

стые состояния, описываемые гибридизованными волновыми функциями $\text{Cu}3d_{x^2-y^2} + \text{O}2p_x, y$ купратных плоскостей (зоны A_1 и A_2), либо связать его с ветвью C , определяемой цепочками CuO . Однако, учитывая, что аналогичный переход наблюдается и в соединениях на основе La , где цепочки от-

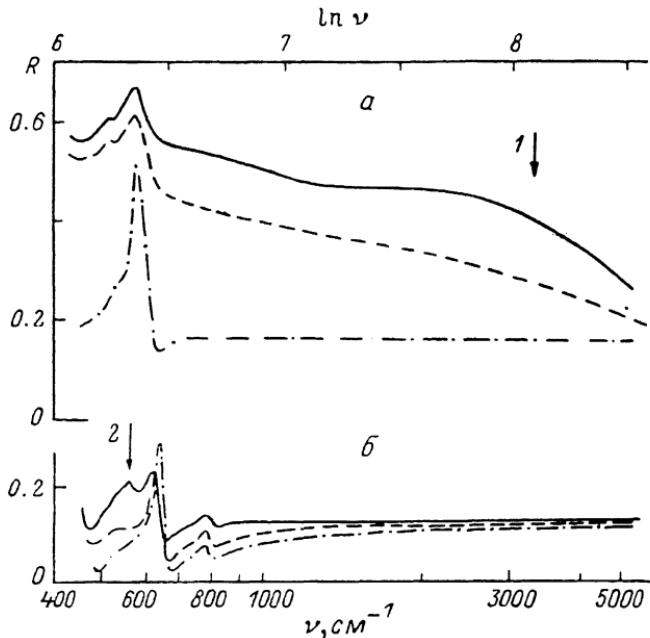


Рис. 1. Влияние изохронного отжига в вакууме на спектры отражения монокристалла $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ в поляризациях $E \perp C$ (а) и $E \parallel C$ (б).

Волновой вектор света $q \perp C$. Сплошные кривые — спектры исходного образца, пунктир и штрих-пунктир — спектры после отжигов при 200 и 300 °C соответственно. Стрелками отмечены электронный переход 1 в районе 3500 cm^{-1} (0.45 эВ), проявляющийся в поглощении около 0.6 эВ, и переход 2 — 565 cm^{-1} (0.07 эВ).

существуют, следует остановиться на первом варианте. Таким образом, переход происходит в точке S зоны Бриллюэна, причем в качестве начального состояния выступает, по-видимому, ветвь, определяемая гибридизованными волновыми функциями кислорода и $\text{Cu}3d_{z^2-r^2}$.

В спектральном диапазоне, где локализованы линии оптических фононов, наблюдалась сравнительно слабые «лишние» линии 530 cm^{-1} ($E \perp C$) и 565 ,

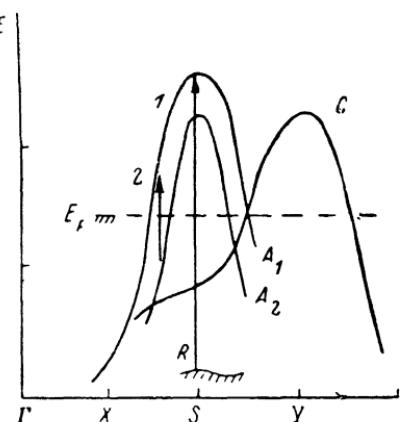


Рис. 2. Схема электронных переходов 1 (0.6 эВ) и 2 (0.07 эВ) рис. 1.

Двухмерные зоны A_1 и A_2 определяются комбинацией $\text{Cu}3d_{x^2-y^2} + \text{O}2p_x, y$ орбиталей купратных плоскостей, одномерная C -зона — цепочками CuO , R -зона — гибрид волновых функций $\text{Cu}3d_{z^2-r^2}$ и кислорода.

787 cm^{-1} ($E \parallel C$). Линия 565 cm^{-1} отличается тем, что ее интенсивность уменьшается аналогично переходу 0.6 эВ при снижении содержания кислорода в результате отжигов в вакууме (рис. 1). Такая «лишняя» линия (570 cm^{-1}) наблюдалась и в спектрах комбинационного рассеяния (КР) и объяснялась проявлением ИК-активной моды в поле дефектов кристалла [12]. В то же время при исследовании спектров пропускания порошков аналогичное поведение линии 575 cm^{-1} связывалось с проявлением КР-активной моды в ИК спектре вследствие ее взаимодействия с нижележащим электронным переходом [9] либо с Cu1—O4 антисиммет-

ричным колебанием, взаимодействующим с электронным переходом с переносом заряда [13]. Не отрицая моделей [9, 12, 13], заметим, что не исключена возможность объяснения природы линии 565 см^{-1} (0.07 эВ), активной в поляризации $E \parallel C$, как электронного перехода из заполненных состояний зоны A_2 (рис. 2) в пустые состояния A_1 в области уровня Ферми E_F . В таком случае падение интенсивностей линий 0.07 и 0.6 эВ с уменьшением содержания кислорода (и соответственно концентрации свободных носителей) можно объяснить либо подъемом E_F выше зоны A_1 , либо радикальной перестройкой зонной схемы (рис. 2), рассчитанной для металлического состояния, при переходе к диэлектрической фазе.

Авторы выражают благодарность Е. Г. Максимову за полезные обсуждения данной работы.

Список литературы

- [1] Bozovic I., Kirillov D., Kapitulnik A. e. a. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 59. N 19. P. 2219—2221.
- [2] Lu F., Perry C. H., Chen K. e. a. // J. Opt. Soc. Am. B. 1989. V. 6. N 3. P. 396—402.
- [3] Eklund P. C., Rao A. M., Lehman G. W. e. a. // J. Opt. Soc. Am. B. 1989. V. 6. N 3. P. 389—395.
- [4] Gervais F., Echegut P., Bassat J. M. e. a. // Phys. Rev. B. 1988. V. 37. N 16. P. 9364—9372.
- [5] Nichol A. C., Pratt F. L., Hayes W. e. a. // J. Opt. Soc. Am. B. 1989. V. 6. N 3. P. 403—408.
- [6] Tanaka J., Shimada M., Mizutani U. e. a. // Phys. C. 1988. V. 153—155. P. 1752—1755.
- [7] Schlesinger Z., Collins R. T., Kaiser D. L. e. a. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 59. N 17. P. 1958—1961.
- [8] Geserich H. P., Koch B., Scheiber G. e. a. // Europhys. Lett. 1988. V. 6. N 3. P. 277—282.
- [9] Ruani G., Tallani C., Zamboni R. e. a. // Phys. C. 1988. V. 153—155. P. 645—646.
- [10] Krakauer H., Pickett W. E., Cohen E. // J. Supercond. 1988. V. 1. N 1. P. 111—141.
- [11] Mattheiss L. F., Hamann D. R. // Sol. St. Comm. 1987. V. 63. N 5. P. 395—399.
- [12] McCarty K. F., Hamilton J. C., Shelton R. N. e. a. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 4. P. 2914—2917.
- [13] Sood A. K., Sankaran K., Hariharan Y. e. a. // J. Phys. 1988. V. 31. N 5. P. 389—397.

Институт физики твердого
тела АН СССР
Черноголовка
Московская область

Поступило в Редакцию
19 октября 1989 г.

УДК 669.71 : 539.382. : 537.39

© Физика твердого тела, том 32, № 4, 1990
Solid State Physics, vol. 32, N 4, 1990

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ

O. A. Троицкий, Ю. В. Никитенко

Электронно-пластический эффект (ЭПЭ) представляет собой пластификацию деформируемого металла под влиянием электрического тока, сопровождающую теми или иными тепловыделениями. Для реализации ЭПЭ требуется одновременное действие тока высокой плотности и механических напряжений выше предела текучести. На диаграммах растяжения или сжатия фиксируются сбросы механической нагрузки или скачки деформирующего усилия [1, 2]. Они являются результатом удлинений (или укорочений в случае сжатия) образцов под действием импульсов тока, которые, вообще говоря, могут включать в себя, помимо ЭПЭ, и тепловую дилатацию (удлинение), а также пондеромоторную часть действия тока.